
	<h2>SIR408DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR408DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR408DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10350 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR408DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10350 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 50A (Tc) 4.8W (Ta), 44.6W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 44.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1230pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR408DP-T1-GE3TR

SIR408DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR408DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR408DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR408DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR406DP-T1-E3 VISHAY SIR406DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR406DP-T1-GE3-S VISHAY SIR406DP-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p>SIR406DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR410DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR406DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR408DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR410DP-T1 VISHAY SIR410DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SIR410DP SI SIR410DP SI</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited